





	<h2 style="color: red;">SI7664DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7664DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7664DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7664DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7770pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	125nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40A (Tc) 5.4W (Ta), 83W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SI7664DP-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7664DP-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7664DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI7664DP-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7661ESA+T Maxim Integrated IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8SOIC</p>	 <p>SI7661CSA+T Maxim Integrated IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8SOIC</p>	 <p>SI7664DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7661DJ Maxim Integrated IC REG SWTCHD CAP INV RATIO 8DIP</p>
 <p>SI7664DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7668ADP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7661ESA+ Maxim Integrated IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8SOIC</p>	 <p>SI7668ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7664DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7664DP-T1-E3 Datenblatt	SI7664DP-T1-E3-Datenblätter	SI7664DP-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7664DP-T1-E3
SI7664DP-T1-E3 Electronic	SI7664DP-T1-E3-Komponenten	SI7664DP-T1-E3-Verteiler	SI7664DP-T1-E3-Bild	SI7664DP-T1-E3-Teil
SI7664DP-T1-E3 Preis	SI7664DP-T1-E3 Hersteller	SI7664DP-T1-E3 Bild	SI7664DP-T1-E3 Aktie	SI7664DP-T1-E3 Inventar
SI7664DP-T1-E3 Neu	SI7664DP-T1-E3 Original	SI7664DP-T1-E3 garantiert	SI7664DP-T1-E3 RFQ	SI7664DP-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited